



**РОГАЧЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА**  
**(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)**

21 октября 2012 года исполнилось 75 лет со дня рождения Елены Ивановны Рогачевой – член-корреспондента Международной термоэлектрической академии, доктора физико-математических наук, профессора, известного ученого в области термоэлектрического материаловедения.

Закончив в 1960 году Харьковский политехнический институт (в настоящее время – Национальный технический университет «ХПИ»), Е.И. Рогачева работала в лаборатории полупроводников НИИ основной химии, одновременно обучаясь в аспирантуре при кафедре металлофизики под руководством проф. Палатника Л.С. В 1968 году стала кандидатом технических наук, а в 1990 году – доктором физико-математических наук по специальности «Физика полупроводников и диэлектриков». С 1967 г. по сегодняшний день работает в НТУ «ХПИ», с 1991 г. – профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики, руководитель лаборатории полупроводникового материаловедения, на базе которой создан учебный лабораторный практикум. Под ее руководством защищено 8 кандидатских диссертаций. Профессор Е.И. Рогачева – член специализированного совета по защите докторских диссертаций, член секции полупроводникового материаловедения Научного Совета НАНУ по проблеме «Физика полупроводников»; член редколлегии журнала «Термоэлектричество», член международного оптического, украинского физического и термоэлектрического обществ, с 2007 года – член-корреспондент Международной термоэлектрической академии.

Основное направление исследований – разработка научных основ ТЭ материаловедения, включающего в себя такие вопросы, как физика фаз переменного состава, нестехиометрия и примеси в полупроводниках, размерные эффекты в наноструктурах.

Работы школы профессора Е.И. Рогачевой хорошо известны международному научному сообществу. Она – автор и соавтор более 230 научных работ (в том числе двух монографий), многие из которых опубликованы в ведущих международных журналах, и около 300 докладов на международных конференциях.

В 2005 г. Е.И. Рогачева награждена памятной медалью Фонда CRDF и почетной грамотой Министерства образования и науки Украины «За значительный вклад в развитие международного сотрудничества между Украиной и США», в 2008 г. стала лауреатом премии «Интеллект Харькова» им. Л.С. Палатника, в 2009 г. получила почетную грамоту Международной термоэлектрической академии «За достижения в области термоэлектрического материаловедения», в 2010 г. награждена знаком «За научные достижения» Министерства образования и науки Украины.

Международная термоэлектрическая академия, Институт термоэлектричества НАН и МОНМС Украины, редакция журнала «Термоэлектричество» поздравляют уважаемую Елену Ивановну Рогачеву с 75-летним юбилеем, желают крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и творческих достижений в работе.